

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d) - Galliumoxid für die Leistungselektronik -

Für unsere Abteilung Leistungselektronik suchen wir eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in.

(Kennziffer 14/20)

Aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften besitzt das Halbleitermaterial β -Ga₂O₃ das Potential die Effizienz von Leistungskonvertern maßgeblich zu verbessern. Im Rahmen von derzeitigen Forschungsaktivitäten am FBH sollen vertikale Transistorstrukturen auf der Basis von β -Ga₂O₃ entwickelt, hergestellt und messtechnisch charakterisiert werden. Bereits in der Entwicklungsphase sind wichtige Parameter im Bauelementdesign festzulegen. Dieses erfordert modernste Bauelementsimulatoren. Durch einen messtechnischen Abgleich der prozessierten Transistorstrukturen mit den Simulationsergebnissen können prozessbegleitend durchgehende Optimierungen des Bauelementdesigns ausgeführt werden.

Für die Durchführung dieser Tätigkeiten suchen wir eine(n) Nachwuchswissenschaftler(in) aus dem Bereich der Ingenieur-, Natur- oder Materialwissenschaften mit einschlägiger Erfahrungen auf dem Gebiet der Halbleiterphysik sowie im Umgang mit Simulationssoftware (z.B. ANSYS, Silvaco-Atlas etc.).

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) in den Fächern Physik, Elektrotechnik oder Materialwissenschaften mit nachgewiesenen Kursen aus dem Bereich der Physik von Halbleiterbauelementen.

Teamfähigkeit und engagiertes, selbständiges Arbeiten sowie sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sind erforderlich. Entsprechende deutsche Sprachkenntnisse sind erwünscht. Zudem besteht die Möglichkeit zur Promotion.

Die Stelle kann zum nächstmöglichen Termin besetzt werden und ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach TVöD (Bund).

Ein besonderes Augenmerk kommt der Gleichstellung der Geschlechter zu. Das Institut ist bestrebt, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen. Daher sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Dazu klicken Sie bitte auf „[Online bewerben](#)“ und übermitteln uns auf diesem Wege Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum **17. Juli 2020**.

Falls Sie noch Fragen zur Bewerbung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Nadine Kelm, Tel. 030 6392 2691.

E-Mail: Nadine.Kelm@fbh-berlin.de

Profil

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) im Forschungsverbund Berlin e. V. ist ein international führendes Forschungsinstitut auf den Gebieten der Diodenlaser UV-LEDs und der Mikrowellenbauelemente.

Auf der Basis von III/V Halbleitern erforscht und realisiert es Komponenten und Systeme u.a. für Anwendungen in Kommunikation, Verkehrs- und Produktionstechnik, Medizin und Biotechnologie. Es verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zu lieferfertigen Systemen.

Weiteres unter: www.fbh-berlin.de